新規ベンゾチエノイソインジゴ骨格の合成とキャリア輸送特性

(東工大院理工)〇長谷川 司、芦沢 実、松本 英俊

Design and structure-property relationship of benzothienoisoindigo in organic field effect transistors

(Tokyo Tech) Tsukasa Hasegawa, Minoru Ashizawa, Hidetoshi Matsumoto

【序】インジゴブルー色素の構造異性体であるイ ソインジゴ(II)骨格は電子アクセプターであり、II 骨 格を構成要素とする有機半導体材料は有機電界効果 トランジスタ(OFET)に応用され、高い電荷輸送特性 を示すことが報告されている[1]。しかし、II 骨格は フェニル環のプロトンとカルボニル基の酸素原子間 の立体障害から中心の二重結合でねじれが生じてお り、密な分子間パッキングの形成や効率的な電荷輸 送にとって不利である。一方、II 骨格のフェニル環



Fig 1. Chemical structures of II, TII, and BTII

をチオフェン環で置換したチエノイソインジゴ(TII)骨格はチオフェン環の硫黄原子とカルボニル 基の酸素原子の相互作用により完全に平面な骨格である[2]。TII 骨格をアクセプターとしたドナ ー/アクセプター型分子は高い電荷輸送特性及び狭バンドギャップを示すことが報告されている [3]。有機半導体において、 π 共役系の拡張は電子構造や分子配列の制御が期待できるとともに、 HOMO-LUMO 間のエネルギーギャップの減少に貢献し、p型及びn型の両方で駆動するアンバイ ポーラ特性の発現に有利である。我々はこれまでに、TII 骨格にベンゾチオフェンを結合したドナ ー/アクセプター型低分子を合成し、10⁻² cm² V⁻¹ s⁻¹ 程のバランスの良いホール、電子移動度を示す ことを報告した[4]。本研究では、TII 骨格の平面性を活かして π 共役系を拡張し、TII 骨格にフェ ニル環を縮環させたベンゾチエノイソインジゴ(BTII)骨格を合成した(Fig 1)。BTII の物理化学的特 性、単結晶構造、電荷輸送特性を II、TII と系統的に比較して評価した[5]。

【実験】

①合成 BTII は 3-ブロモベンゾチオフェンを出発物として 3 ステップを経て合成した(Scheme 1)。II 及び TII は先行文 献に従って合成した[6,7]。なお各分子の側鎖には溶解性を付 与するため n-ヘキシル基を導入した。

②単結晶作製 構造解析用の単結晶はII及びTIIはクロロホ ルム/メタノール溶液、BTIIはトルエン/クロロホルム溶液を 用いて拡散法により作製した。

③**OFET**作製 SiO₂/Si 基盤上に Tetratetracontane(C₄₄H₉₀, TTC) を製膜した後、真空蒸着法により各分子から薄膜を形成した。 さらに金を真空蒸着することで、チャネル長 50 µm、チャネ ル幅 1000 µm のソース/ドレイン電極を形成し、ボトムゲー ト/トップコンタクト型 **OFET** を作製した。また薄膜作製時 の基盤温度の影響を調べるために、自己組織化膜として

Octadecyltrimethoxysilane(OTMS)を修飾した基盤に対し、基 般温度を変えて活性層を形成した OFET も作制した かお酒



Scheme 1. Synthetic route of BTII

盤温度を変えて活性層を形成した OFET も作製した。なお測定は全て真空条件下で行った。

【結果と考察】

B3LYP/6-31⁺(d,p)を用いた密度汎関数(DFT)計算を行った結果、BTII 骨格は TII 骨格と同様に完全 に平面な骨格であることが示された。また各分子のフロンティア電子軌道は π 共役骨格に沿って 広く非局在化しており、HOMO、LUMO 準位はそれぞれ II: -5.89 eV, -2.99 eV, TII: -5.32 eV, -2.84 eV, BTII: -5.19 eV, -3.08 eV と求められ、エネルギーギャップは II > TII > BTII の順に減少することが 示唆された。熱重量(TGA)測定から求めた各分子の 5%重量減少温度は II: 299 °C、TII: 296 °C、BTII: 367 °C となった。融点は II:113 °C、TII:122 °C である一方、BTII は分解温度のみを示した。この結 果から、 π 共役系の拡張は π - π 分子間相互作用に由来する強固な分子間 π - π スタックの形成により、 熱安定性が向上することが示唆された。クロロホルム溶液中の紫外-可視-近赤外(UV-Vis-NIR)吸収 スペクトルでは分子内電荷移動に由来するピークにおいて、II < TII < BTII の順にモル吸光係数の 増加と長波長シフトしたスペクトルが得られた。また吸収スペクトルの吸収端から算出した光学 的エネルギーギャップは II > TII > BTII の順に減少しており、 π 共役系の拡張が示唆された。薄膜 の吸収スペクトルを溶液のそれと比較すると、II ではほぼ同じてあるのに対し、TII 及び BTII で

はスペクトルがレッドシフトしており、薄膜中の強い分子 間相互作用が示唆された。サイクリックボルタンメトリー (CV)測定からフェロセンを基準として求めたエネルギー 準位では、TII は II よりも 0.2 eV 程度の HOMO 準位の上 昇と LUMO 準位の下降が観察された。一方、BTII は TII と比べ LUMO 準位はほぼ一定であったが 0.2 eV 程度の HOMO 準位の上昇が確認され、フェニル環による π 共役 系の拡張は HOMO 準位の上昇に寄与することが示唆され た(Table 1)。これらの結果は DFT 計算の傾向と良い一致を 示した。単結晶 X 線構造解析の結果から、TII は電荷輸送 に不利な分子間の重なりの少ない構造をとる(Fig 2(c))。-方で、II 及び BTII は π スタック距離がそれぞれ 3.33 Å、 3.40 Åの一次元的カラム構造をとり、電荷輸送に好ましい ー次元伝導パスの形成が示唆された(Fig 2(a),(e))。また tight-binding 法により算出したスタック方向のトランスフ ー積分は HOMO、LUMO ともに 50~70 meV 程の値を示 した。TTC を修飾した OFET において、全ての分子でアン バイポーラ特性を示した。 キャリア移動度は II 及び TII で は 10⁻⁵-10⁻⁴ cm² V⁻¹ s⁻¹の値に対し、BTII では特性は向上し ホール移動度が 0.095 cm² V⁻¹ s⁻¹、電子移動度が 5.8×10⁻³ cm² V⁻¹ s⁻¹ を示した。さらに OTMS を修飾した OFET にお いて、BTII はホール移動度が 0.18 cm² V⁻¹ s⁻¹ の p 型特性を 示した。各薄膜の面外方向における X 線回折(XRD)測定で は、一次の明瞭な回折ピークが得られ、そのピークから求 めた面間隔と単結晶構造から基盤に対するチルト角を算



Fig 2. Molecular packing and AFM image of (a) and (b) II, (c) and (d) TII, and (e) and (f) BTII.

出した結果、II は 47°、TII は 9°、BTII は 20°と見積もられた。AFM 画像から観察した薄膜の表 面モルフォロジーは、II では欠陥の多く有する大きなプレート上のグレインを形成していること が示された(Fig 2(b))。TII では II よりも表面粗さが減少するが、不連続なプレート状のグレインが 確認された(Fig 2(d))。II 及び TII の欠陥の存在する不連続なグレインが、低いキャリア移動度を示 した原因と考えられる。一方、BTII は表面粗さが小さく、連続したナノロッド状のグレインが確 認された(Fig 2(f))。BTII の拡張した π 共役系は島状成長メカニズムによる横方向に成長した結晶 グレインの形成に寄与することが示唆され、この表面モルフォロジーは効率的な電荷輸送を促進 し、高いキャリア移動度に貢献したと考えられる。

	$\lambda_{\max}^{\text{sol. }a}(\varepsilon_{\max}{}^{a})$	$\lambda_{\max}^{\text{film. }b}$	$E_{ m g}^{ m opt. } {}^c$	$E_{\text{HOMO}}^{\text{CV.} d}$	$E_{\text{LUMO}}^{\text{CV.} d}$	$E_{\rm g}{}^{{ m CV.}e}$
	$[nm]([10^4 M^{-1} cm^{-1}])$	[nm]	[eV]	[eV]	[eV]	[eV]
Π	395 (1.29), 500 (0.41)	378, 501	2.03	-5.41	-3.10	2.31
TII	381 (1.25), 401 (1.10), 552 (0.91)	388, 409, 567	1.88	-5.21	-3.35	1.86
BTII	419 (1.83), 437 (1.81), 651 (1.30)	437, 678, 733	1.57	-5.07	-3.38	1.69

Table 1. Optical and electrochemical properties of II, TII, and BTII

^{*a*} In CHCl₃ solution. ^{*b*} Spin-coated thin films. ^{*c*} Estimated from the solution absorption onset. Estimated from cyclic voltammetry vs Fc/Fc⁺ ($E_{HOMO} = -4.80 \text{ eV}$). ^{*e*} $E_g^{CV} = E_{LUMO}^{CV} - E_{HOMO}^{CV}$.

References

[1] E. Wang, W. Mammo, and M. R. Andersson, Adv. Mater., 2014, 26, 1801-1826.

[2] R. S. Ashraf, A. J. Kronemeijer, D. I. James, H. Sirringhaus, and I. McCulloch, *Chem. Commun.*, **2012**, 48, 3939-3941.

[3] G. Kim, S.-J. Kang, G. K. Dutta, Y.-K. Han, T. J. Shin, Y.-Y. Noh, and C. Yang, *J. Am, Chem, Soc.*, **2014**, *136*(26), 9477-9483.

[4] T. Odajima, M. Ashizawa, Y. Konosu, H. Matsumoto, and T. Mori, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 10455-10467.

[5] T. Hasegawa, M. Ashizawa, and H. Matsumoto, RSC Adv., 2015, 5, 61035-61043.

[6] L. A. Estrada, D. Y. Liu, D. H. Salazar, A. L. Dyer, and J. R. Reynolds, *Macromolecules*, **2012**, 45, 8211-8220.

[7] R. R. Dasari, A. Dindar, C. K. Lo, C.-Y. Wang, C. Quinton, S. Singh, S. Barlow, C. F. Hernandez, J. R. Reynolds, B. Kippelen, and S. R. Marder, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2014**, *16*, 19345-19350.